(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(川)特許番号

第2731562号

(45) 発行日 平成10年(1998) 3月25日

(24)登錄日 平成9年(1997)12月19日

(51) Int.CL ⁸	識別配号	庁内整極番号	PI		技術	表示箇所
BOIJ 27/224			B01J	27/224	Z	
B 0 1 D 53/86				37/14		
B 0 1 J 37/14			B01D	53/36	С	

前球項の数3(全 3 頁)

(21)出顧番号	特顧略63-334147	(73)特許指者	999908999
		•	イビデン株式会社
(22)出題日	昭和63年(1988)12月29日		岐阜県大理作特田町2丁目1番地
		(72) 死明者	大禍 袋英
(65)公問番号	特買平2-180641		岐阜県大塩市河間町3丁目200番地 イ
(43)公開日	平成2年(1990)7月13日		ピデン株式会社河間工場内
		(72) 觉明者	山内 奖使
			岐阜県大垣市河間町3丁目200番地 イ
			ビデン株式会社河間工場内
		(74)代理人	弁理士 思田 神富
		容查官	新居田 知生
		(56)参考文献	特丽 阿62-45344 (JP, A)

(54) 【発明の名称】 触媒担体及びその観造方法

(57)【特許請求の範圍】

【請求項1】予めハニカム状に形成した多孔質炭化達素焼結体を融化雰囲気にて所定温度で加熱することにより、この焼結体の孔部内面において前記焼結体の炭化珪素の一部を酸化して触媒担持用のシリカ膜を形成することを特徴とする触媒担体の製造方法。

【請求項2】ハニカム状に形成された多孔質炭化珪素焼結体の孔部内面に触媒担持用のシリカ膜が形成され、そのシリカ膜を含む多孔質炭化珪素焼結体の酸素濃度は0.005wt%から2wt%であることを特徴とする触媒担体。

【請求項3】前記シリカ競を含む多孔貿焼結体中の酸素 は炭化珪素結晶の表層部に存在することを特徴とする請 求項2に記載の触媒担体。

【発明の詳細な説明】

〔産業上の利用分野〕

この発明はディーゼルエンジン等の内無機関における 排気ガスを浄化処理するための無線成分を担待可能な触 葉担体及びその製造方法に関する。

【従来の技術】

従来、例えばディーゼルエンジンの排気ガスを浄化する場合には、コージエライトによってハニカム状に形成した触媒担体と、その触媒担体に担持された触媒成分とを有するフィルターをディーゼルエンジンの排気側に接続し、このフィルターによって前記排気ガス中のカーボ10 ン、NG及びHC等を酸化分解するようになっている。

[発明が解決しようとする課題]

ところが、上記のフィルターにおける触媒担体は融点 (1200~1300°C)の低いコージエライトによって形成されているため、フィルター内において、俳気ガスの不均一な燃焼が生じて、局部的な温度上昇が生じると、触媒 担体が部分的に溶解する。そして、ディーゼルエンジン の使用が停止されて、フィルターが冷却された時、前記 溶解部分から触媒担体にクラックが発生し、フィルター の概能が低下するという問題があった。

上記の問題を解決するため、触媒担体として耐熱性及 び熱圧等性に優れた炭化珪素焼結体を使用することがす でに提案されている (特開昭62-45344号公報)。 この 4 公報に関示された触媒担体においては、炭化珪素焼結 体にコロイダルシリカを浸透させた後に高温で飼熱する ことによって、統結体内外における炭化珪素粒子の表面 に触媒担待用のシリカ膜を形成するようになっている。

そのため、コロイダルシリカという特別な材料が必要 になると共に、工程数が増加して手間がかかるばかりで なく、焼結体の内部の細孔がコロイダルシリカ等の塗布 剤に閉塞され易く、焼結体の圧力損失が増大するという 問題がある。

との発明は上記の事績を考慮してなされたものであっ て、その目的は炭化珪素統結体の強度低下を招くことな く、極めて簡単な方法によって触媒担体の孔部内面に所 望の厚さのシリカ膜を確実に形成することが可能な触媒 20 担体の製造方法を提供することにある。

[課題を解決するための手段及び作用]

上記の目的を達成するために、この発明では、予めハ ニカム状に形成した多孔質炭化珪素焼結体を酸化雰囲気 にて所定温度で加熱することにより、この焼結体の孔部 内面において前記焼結体の炭化珪素の一部を酸化して鮭 **模担持用のシリカ膜を形成するようにしている。**

又、炉の有効容論が6.4㎡の場合、前記酸化雰囲気は 炭化珪素焼結体に対して毎分1~200の割合で供給され る空気によって形成され、かつ加熱温度及び加熱時間は 30 それぞれ600~1200°C及び0.3~1d時間に設定されること が望ましい。

上記の製造方法によって触媒担体を製造すると、多孔 質炭化珪素焼結体の孔部内面において、炭化珪素の一部 が酸化されて、炭化珪素結晶の豪層部にシリカ膜が形成 される。シリカ膜を含む多孔質炭化珪素焼結体の酸素濃 度は0.505wt%から2wt%の節題であることが必要であ る。酸素濃度が0.005m%より少ないと、前記焼結体の 孔部内面の表層に形成されるシリカ騰が薄く、貴金属元 素を有する酸化物系触媒を担待させる場合に、前記シリ カ購が剥離し、前記酸化物系触媒と多孔質炭化珪素焼箱 体とのぬれ性が悪く、担体に十分な強度を持たせること が困難になる。酸素濃度が2mt%より多いと、シリカ膜 が厚くなり、母体の多孔智炭化珪素焼結体との熱膨張の ミスマッチングが生じて強度の劣化を生じる。酸素濃度 が0.006~0.1мπ%の範囲がより好ましい。

以下、この発明を図面に従って詳細に説明する。第1 図及び第2図に示すように、触媒担体を構成する基材1 は高い融点(~3000℃)を有する多孔貿炭化珪素締結体 によってハニカム状に形成されると共に、全体として円 50 的に供給しながら、800°Cで1時間にわたって加熱し、

柱状をなしている。そして、この基村1には軸線方向に 平行に延びる多数のガス通過孔2が形成され、各ガス通 過孔2の供給側及び排出側のいずれか一端が炭化珪素質 の小片3によって交互に封止されている。この基材1に おいて、各ガス通過孔2の内壁面には所定の酸素濃度 (0.005~2wc%)を有するシリカ膜が形成されている。

そこで、触媒担体の製造方法について説明すると、先 ず、炭化珪素粉末を主成分とする原料により、例えば本 件出願人による特闘昭61-259763号公報に記載された公 知の方法に従って、所定の密度、曲げ強度、比表面積及 び所定の酸素濃度(6,602~6,8wt%、好ましくは0,0024 ~0.04vt%)を有するハニカム状基村1を焼成する。ぞ して、この基付1を炭化珪素製の炉に入れた後、毎分1 ~200の空気を炉内に強制的に送り込んで循環させると 同時に、炉内の温度を0.3~10時間にわたって600~1200 Cの範囲の温度に保持する。

この加熱温度が600°C未満であると、酸化反応が起こ り転く、1200°Cを越えると、酸化反応が進みすぎて、シ リカ驥が焼結体内部まで形成されて、強度低下を招く。

上記の加熱処理により、各ガス通過孔2の内壁面及び 基付1の表面において、炭化珪素結晶の表層部が酸化さ れ、所定の酸素温度(0.005~2wt%)のシリカ膜が形成 される。このシリカ膜は前記空気量、加熱時間、加熱温 度及び基材1の比表面領等に依存して変化するため、こ れらを制御することにより、所望の酸素濃度の均一なシ リカ膜を形成できる。その後、前記シリカ膜に、白金に 代表される白金族元素やその他の金属元素及びその酸化 物等からなる酸化触媒を担持させれば、内熱機関等の排 気ガス浄化用フィルターが形成される。

そして、緋気ガスが緋気道路4内において、第1図に 矢印で示すように、その供給側から益付1内に導入され ると、ガス通過孔2間の壁部により、排気ガス中のカー ボンや水等が滤過されると共に、シリカ膜上の触媒によ り、酸化される。そして、浄化された排気ガスが基材1 から排出される。

尚、触媒を基付1のシリカ膜に担持させるには、下記 の方法を使用できる。即ち.

- (a) 触媒成分を含むスラリーを基材1の一端面側か ち吹き掛ける。
- (b) 触媒成分を含むスラリー中に基材 1を数回接漬 する。この場合、触媒成分を基材 1 の中央部よりも両端 部に多く担待させたり、その逆にしたりする。
 - (c) 触媒成分を含むスラリーを塗布する。 (実能例)

8型の結晶構造を有する炭化珪素粉末を主成分とする 原料の押出成形加工により、密度が1.2g/cm/ .曲け強度 が180kg/cm',比表面論が0.2ml/g、酸素濃度が9.008wc% のハニカム状華村1を形成し、この華村1を有効容績が 0.4㎡の炉内に入れ、その炉内に毎分1.8の空気を強制

た。それにより、ガス通過孔2の内面全体に、胶素濃度 として0.02wc%のシリカ膜が形成され、シリカ膜の形成 後に基材1の曲け強度が低下することもなかった。 (発明の効果)

以上詳述したように、語求項1記載の発明は炭化珪素 焼結体の強度低下を招くことなく、極めて簡単な方法に よって触媒担体の孔部内面に所望のシリカ膜を暗実に形 成することができるという優れた効果を発揮する。 * また、請求項2及び3記載の発明は最適な厚さのシリカ機が形成される触媒担体を得ることができるという優れた効果を発揮する。

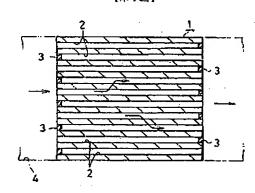
. 5

【図面の簡単な説明】

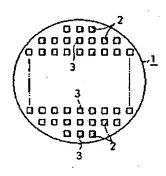
第1回はこの発明の製造方法によって製造される触線担体の断面図、第2図は側面図である。

1……基材、2……ガス通過孔。

【第1図】



【第2図】



* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

(57) [Claim(s)]

[Claim 1] The manufacture approach of the catalyst support characterized by oxidizing in some silicon carbide of said sintered compact in the pore inside of this sintered compact, and forming the silica film for catalyst support by heating the porosity silicon carbide sintered compact beforehand formed in the shape of a honeycomb at predetermined temperature in an oxidizing atmosphere. [Claim 2] The oxygen density of the porosity silicon carbide sintered compact which the silica film for catalyst support is formed in the pore inside of the porosity silicon carbide sintered compact formed in the shape of a honeycomb, and contains the silica film is catalyst support characterized by being 0.005wt(s)% to 2wt(s)%.

[Claim 3] The oxygen in the porosity sintered compact containing said silica film is catalyst support according to claim 2 characterized by existing in the surface section of a silicon carbide crystal.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[Industrial Application]

This invention relates to the catalyst support which can support a catalyst component and its manufacture approach for carrying out purification processing of the exhaust gas in internal combustion engines, such as a diesel power plant.

[Description of the Prior Art]

In purifying the exhaust gas of the former, for example, a diesel power plant, the filter which has the catalyst support formed in the shape of a honeycomb by cordierite and the catalyst component supported by that catalyst support is connected to the exhaust side of a diesel power plant, and it carries out oxidative degradation of the carbon in said exhaust gas, NOX, HC, etc. with this filter. [Problem(s) to be Solved by the Invention]

However, since it is formed of cordierite with the low melting point (1200-1300 degrees C), if uneven combustion of exhaust gas arises in a filter and a local temperature rise arises, catalyst support will dissolve the catalyst support in the above-mentioned filter partially. And when use of a diesel power plant was suspended and a filter was cooled, the crack occurred in catalyst support from said dissolution part, and there was a problem that the function of a filter fell.

In order to solve the above-mentioned problem, using the silicon carbide sintered compact which was excellent in thermal resistance and thermal conductivity as catalyst support is already proposed (JP,62-45344,A). In the catalyst support indicated by these four official reports, after making colloidal silica permeate a silicon carbide sintered compact, the silica film for catalyst support is formed in the front face of a sintered compact internal and external silicon carbide particle by heating at an elevated temperature.

Therefore, while a special ingredient called colloidal silica is needed, a routing counter increases, it not only takes time and effort, but the pore inside a sintered compact tends to be blockaded by paint, such as colloidal silica, and there is a problem that the pressure loss of a sintered compact increases.

It is in this invention being made in consideration of the above-mentioned situation, and that purpose offering the manufacture approach of the catalyst support [without causing the fall of a silicon carbide sintered compact on the strength] which can form the silica film of desired thickness in the pore inside of catalyst support certainly by the very easy approach.

[Means for Solving the Problem and its Function]

In order to attain the above-mentioned purpose, in the pore inside of this sintered compact, he oxidizes in some silicon carbide of said sintered compact, and is trying to form the silica film for catalyst support in this invention by heating the porosity silicon carbide sintered compact beforehand formed in the shape of a honeycomb at predetermined temperature in an oxidizing atmosphere. Moreover, when the sensitive volume of a furnace is 3 0.4m, said oxidizing atmosphere is formed of the air supplied at a rate of per minute one to 20 ** to a silicon carbide sintered compact, and, as for whenever [stoving temperature], and heating time, it is desirable respectively to be set up in 600-1200 degrees C and 0.3 - 10 hours.

If catalyst support is manufactured by the above-mentioned manufacture approach, in the pore inside of a porosity silicon carbide sintered compact, some silicon carbide will oxidize and the silica film will be formed in the surface section of a silicon carbide crystal. The oxygen density of the porosity silicon carbide sintered compact containing the silica film needs to be the range of 0.005wt(s)% to 2wt(s)%. If there are few oxygen densities than 0.005wt(s)%, the silica film formed in the surface of the pore inside of said sintered compact is thin, when making the oxide system catalyst which has a noble-metals element support, said silica film will exfoliate, the wettability of said oxide system catalyst and a porosity silicon carbide sintered compact will be bad, and it will become difficult to give sufficient reinforcement for support. If there are more oxygen densities than 2wt(s)%, the silica film will become thick, mismatching of thermal expansion with the porosity silicon carbide sintered compact of a parent will arise, and strong degradation will be produced. The range of 0.006 - 0.1wt% has a more desirable oxygen density.

Hereafter, this invention is explained to a detail according to a drawing. As shown in a 1st [**] Fig. R> Fig. and Fig. 2, the base material 1 which constitutes catalyst support is making the shape of a cylinder as a whole while being formed in the shape of a honeycomb with the porosity silicon carbide sintered compact which has the high melting point (-3000 degrees C). And the gas passage hole 2 of a large number prolonged in parallel is formed in the direction of an axis at this base material 1, and the closure of the any 1 edge by the side of supply of each gas passage hole 2 and discharge is carried out by turns by the wafer 3 of the quality of silicon carbide. In this base material 1, the silica film which has a predetermined oxygen density (0.005 - 2wt%) is formed in the internal surface of each gas passage hole 2.

Then, explanation of the manufacture approach of catalyst support first calcinates the honeycomb-like base material 1 which has a consistency, flexural strength, a predetermined specific surface area, and a predetermined, predetermined oxygen density (0.002 - 0.8wt%, preferably 0.0024 - 0.04wt%) with the raw material which uses silicon carbide powder as a principal component according to the well-known approach indicated by JP,61-259763,A by this applicant. And the temperature in a furnace is held to the temperature of the range of 600-1200 degrees C over 0.3 - 10 hours at the same time it sends in compulsorily the air of per minute one to 20 ** in a furnace and circulates it, after putting this base material 1 into the furnace made from silicon carbide.

If oxidation reaction cannot occur easily that whenever [this stoving temperature] is less than 600 degrees C and 1200 degrees C is exceeded, oxidation reaction progresses too much, and the silica film will be formed to the interior of a sintered compact, and will cause a fall on the strength.

Of the above-mentioned heat-treatment, in the internal surface of each gas passage hole 2, and the front face of a base material 1, the surface section of a silicon carbide crystal oxidizes and the silica film of a predetermined oxygen density (0.005 - 2wt%) is formed. Since this silica film changes depending on the specific surface area of whenever [said air content, heating time, and stoving temperature], and a base material 1 etc., it can form the uniform silica film of a desired oxygen density by controlling these. Then, if the oxidation catalyst which becomes said silica film from the platinum group metals represented by platinum, other metallic elements,

its oxide, etc. is made to support, filters for exhaust gas purification, such as an internal combustion engine, will be formed. And while carbon, HC, etc. in exhaust gas will be filtered by the wall between the gas passage holes 2 if introduced in a base material 1 from the supply side as exhaust gas shows in Fig. 1 by the arrow head in a flueway 4, it oxidizes according to the catalyst on the silica film. And the purified exhaust gas is discharged from a base material 1.

In addition, the following approach can be used in order to make the silica film of a base material 1 support a catalyst. Namely, (a) The slurry containing a catalyst component is blown from the end side of a base material 1.

(b) A base material 1 is immersed several times into the slurry containing a catalyst component. In this case, more catalyst components to both ends than the center section of the base material 1 are made to support, or are made into that reverse.

(c) Apply the slurry containing a catalyst component.

[Example]

It heated over 1 hour at 800 degrees C, 180kg/cm2 and specific surface area having formed 0.7m2/g, the oxygen density having formed [the consistency / 1.2 g/cm3 and flexural strength] the 0.008wt(s)% honeycomb-like base material 1, and sensitive volume having put in this base material 1 in the furnace of 3 0.4m, and supplying the air of per minute 1 ** compulsorily in that furnace by extrusion-molding processing of the raw material which uses as a principal component the silicon carbide powder which has the crystal structure of beta mold. Thereby, the 0.02wt(s)% silica film was formed in the whole inside of the gas passage hole 2 as an oxygen density, and the flexural strength of a base material 1 did not fall after formation of the silica film. [Effect of the Invention]

As explained in full detail above, invention according to claim 1 demonstrates the outstanding effectiveness that the desired silica film can be certainly formed in the pore inside of catalyst support by the very easy approach, without causing the fall of a silicon carbide sintered compact on the strength.

Moreover, invention claim 2 and given in three demonstrates the outstanding effectiveness that the catalyst support in which the silica film of the optimal thickness is formed can be obtained.

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

The sectional view of catalyst support by which <u>Fig. 1</u> is manufactured by the manufacture approach of this invention, and <u>Fig. 2</u> are side elevations.

1 A base material, 2 .. Gas passage hole.

· * NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

